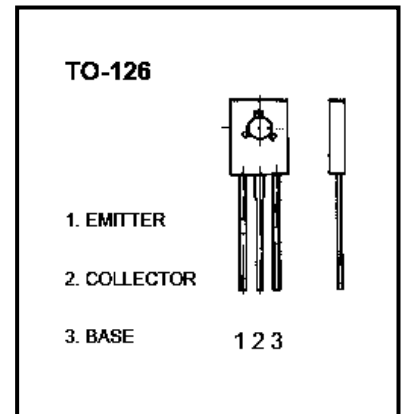


深圳市晶泰源电子有限公司

2SB772 PNP 晶体管

- 1、 封装形式：TO-126
- 2、 互补型号： 2SD882
- 3、 极限参数(绝对最大额定值 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数值	单位
集电极-基极电压	BV_{CBO}	-40	V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	-25	V
集电极最大电流	I_{CM}	-3	A
耗散功率	P_D	2	W
贮存结温	T_j 、 T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$



4、电参数特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极电压	BV_{CBO}	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$	-40			V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$	-25			V
发射极-基极电压	BV_{EBO}	$I_E=-100\mu\text{A}$, $I_C=0$	-6			V
集电极-基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-40\text{V}$, $I_E=0$			-1	μA
集电极-发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-25\text{V}$, $I_B=0$			-10	μA
发射极-基极漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-6\text{V}$, $I_C=0$			-1	μA
直流放大倍数	$H_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$	-60		-400	
	$H_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$	-32			
饱和压降	V_{CESAT}	$I_C=-2\text{A}$, $I_B=-0.2\text{A}$			-0.5	V
正向压降	V_{BESAT}	$I_C=-2\text{A}$, $I_B=-0.2\text{A}$			-2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_B=-100\text{mA}$	50			MHz

深圳市晶泰源电子有限公司
电话：83211536 传真：83206326
地址：华强广场C座11C室